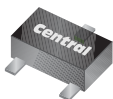


CMUDM8004

**SURFACE MOUNT
P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
SILICON MOSFET**

ULTRAmini™



SOT-523 CASE

• Devices are **Halogen Free** by design

APPLICATIONS:

- Load/Power Switches
- Power Supply Converter Circuits
- Battery Powered Portable Devices

MAXIMUM RATING: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Drain-Source Voltage
Gate-Source Voltage
Continuous Drain Current
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMUDM8004 is an Enhancement-mode P-Channel MOSFET, manufactured by the P-Channel DMOS Process, designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. This MOSFET offers Low $r_{DS(on)}$ and Low Threshold Voltage.

MARKING CODE: 84C

FEATURES:

- ESD Protection up to 2kV
- Low $r_{DS(on)}$
- Low Threshold Voltage
- Logic Level Compatible
- Small, SOT-523 Surface Mount Package
- Complimentary N-Channel MOSFET: CMUDM7004

SYMBOL		UNITS
V_{DS}	30	V
V_{GS}	8.0	V
I_D	450	mA
P_D	250	mW
T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{GSS}, I_{GSSR}	$V_{GS}=8.0\text{V}, V_{DS}=0$			3.0	μA
I_{DSS}	$V_{DS}=30\text{V}, V_{GS}=0$			1.0	μA
BV_{DSS}	$V_{GS}=0, I_D=100\mu\text{A}$	30			V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	0.5		1.0	V
V_{SD}	$V_{GS}=0, I_S=100\text{mA}$			1.1	V
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=430\text{mA}$		1.0	1.1	Ω
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=2.5\text{V}, I_D=200\text{mA}$		1.5	2.0	Ω
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=1.8\text{V}, I_D=100\text{mA}$		2.6	3.3	Ω
$Q_{g(tot)}$	$V_{DS}=10\text{V}, V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=1.0\text{A}$		0.88		nC
Q_{gs}	$V_{DS}=10\text{V}, V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=1.0\text{A}$		0.35		nC
Q_{gd}	$V_{DS}=10\text{V}, V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=1.0\text{A}$		0.128		nC
g_{FS}	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=100\text{mA}$	200			mS
C_{rss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		8.0	10	pF
C_{iss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		45	55	pF
C_{oss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		9.0	15	pF

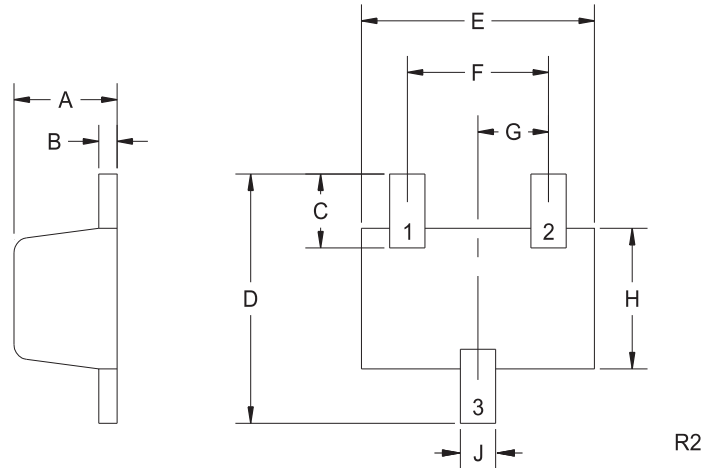
R3 (2-August 2011)

CMUDM8004

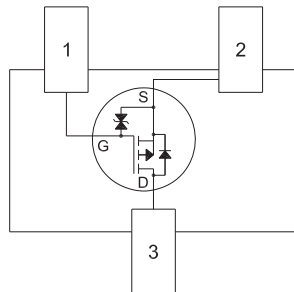
SURFACE MOUNT
P-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
SILICON MOSFET



SOT-523 CASE - MECHANICAL OUTLINE



PIN CONFIGURATION
(Bottom View)



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.023	0.031	0.58	0.78
B	0.002	0.008	0.04	0.20
C	0.013	0.021	0.34	0.54
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.059	0.067	1.50	1.70
F	0.035	0.043	0.90	1.10
G	0.020		0.50	
H	0.031	0.039	0.78	0.98
J	0.010	0.014	0.25	0.35

SOT-523 (REV: R2)

LEAD CODE:

- 1) Gate
- 2) Source
- 3) Drain

MARKING CODE: 84C

R3 (2-August 2011)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9